

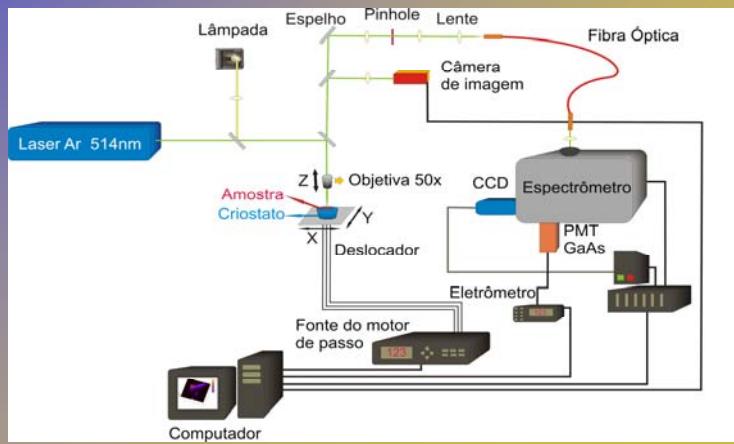
Claudecir R. Biazoli, E. G. Gadret e F. Iikawa

Instituto de Física "Gleb Wataghin" – Unicamp, Campinas-SP, Brasil

## Resumo

Neste trabalho, desenvolvemos um sistema de medida de imagens espaciais de luminescência de nano-estruturas semicondutoras com resolução micrométrica. O sistema será útil para caracterização de nano-estruturas, tais como nanofios e pontos quânticos, sistemas bastante investigados nos últimos anos.

### Montagem experimental



#### Características:

- Resolução espacial:  $\sim 1 \mu\text{m}$
- Temperatura da amostra: 5 a 300 K
- Deslocamento: 12mm / Passo: 10 nm
- Comprimento de onda: 400 – 900 nm

### Aquisição de dados

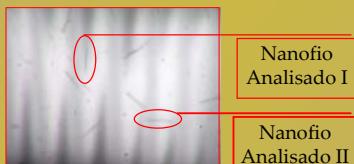
- Softwares:
  1. LabView® (National Instruments) – programa principal de leitura da intensidade (eletrômetro) e varredura espacial (motor-de-passo) – *imagem espacial de emissão óptica*.
  2. LabSpec® (Jobin-Yvon) – programa de leitura do CCD e controle do espectrômetro – *espectro de emissão óptica*.
- Interface IEEE-488 (GPIB) – controle da fonte do motor-de-passo e leitura do eletrômetro.
- Imagem óptica da amostra – via interface de captura de imagem



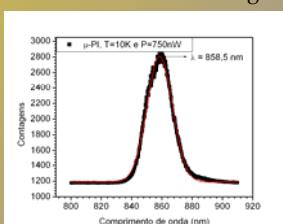
### Resultados

**Amostra:** Nanofios de InP crescidos por método VLS (vapor-liquid-solid) catalisado por nano-partícula de metal (Au).

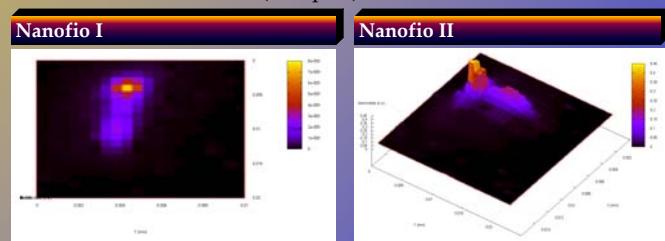
**Imagem óptica:** nanofios de InP depositados sobre um filme de Al/substrato de Si.



**Espectro de  $\mu$ -PL:** medida em um nanofio individual de InP a temperatura de 10K e intensidade do laser na amostra  $9.5 \cdot 10^1 \text{ W/cm}^2$ . Apresentamos as imagens de luminescência em dois formatos diferentes (Gnuplot).



**Imagen espacial de  $\mu$ -PL:** medidas de dois nanofios individuais de InP a temperatura de 10K e intensidade do laser na amostra  $9.5 \cdot 10^1 \text{ W/cm}^2$ . Apresentamos as imagens de luminescência em dois formatos diferentes (Gnuplot).



### Agradecimentos:

- Prof. Dra. M. A. Cotta pelo crescimento de amostras de nanofios